

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年10月7日(07.10.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/201047 A1

(51) 国際特許分類:
C11D 1/62 (2006.01) C11D 3/43 (2006.01)
C11D 3/20 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/013710

(22) 国際出願日: 2021年3月30日(30.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-062932 2020年3月31日(31.03.2020) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 荻野 浩司(OGINO, Hiroshi); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久(OKUNO, Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 柳井 昌樹(YANAI, Masaki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 森谷 俊介(MORIYA, Shunsuke); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 緒方 裕斗(OGATA, Hiroto); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 福田 拓也(FUKUDA, Takuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学

株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO, Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 栗原 浩之, 外 (KURIHARA, Hiroyuki et al.); 〒1500012 東京都渋谷区広尾1丁目3番15号 岩崎ビル6階 栗原国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: CLEANING AGENT COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 洗浄剤組成物及び加工された半導体基板の製造方法

(57) Abstract: A cleaning agent composition which is used for the purpose of removing an adhesive residue. This cleaning agent composition is characterized by containing a quaternary ammonium salt, a metal corrosion inhibitor and an organic solvent, and is also characterized in that the metal corrosion inhibitor is composed of an aliphatic saturated hydrocarbon compound monocarboxylic acid having from 7 to 40 carbon atoms, an aliphatic saturated hydrocarbon compound dicarboxylic acid having from 7 to 40 carbon atoms or an acid anhydride thereof, an aliphatic unsaturated hydrocarbon compound monocarboxylic acid having from 7 to 40 carbon atoms, or an aliphatic unsaturated hydrocarbon compound dicarboxylic acid having from 7 to 40 carbon atoms or an acid anhydride thereof.

(57) 要約: 接着剤残留物を除去するために用いられる洗浄剤組成物であって、第四級アンモニウム塩と、金属腐食抑制剤と、有機溶媒とを含み、上記金属腐食抑制剤が、炭素数7~40の脂肪族飽和炭化水素化合物モノカルボン酸、炭素数7~40の脂肪族飽和炭化水素化合物ジカルボン酸若しくはその酸無水物、炭素数7~40の脂肪族不飽和炭化水素化合物モノカルボン酸、又は炭素数7~40の脂肪族不飽和炭化水素化合物ジカルボン酸若しくはその酸無水物からなることを特徴とする洗浄剤組成物。

[続葉有]

WO 2021/201047 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）